

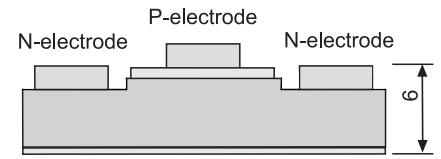
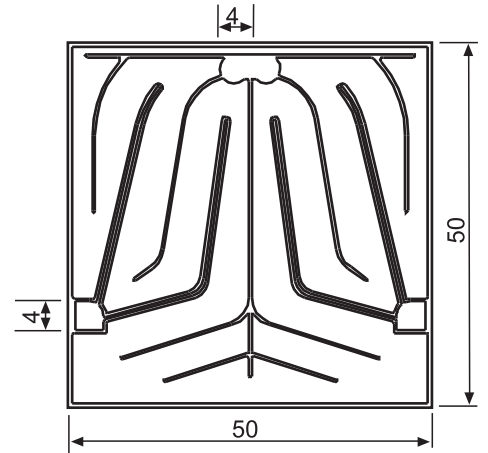


◆ 产品特点:

- 高亮度、长寿命
- 低电流驱动, 损耗小
- 户内外应用
- 芯片百分百测试分选
- 波长和光强良好的一致性

◆ 物理参数:

P电极	金
N电极	金
芯片尺寸	50mil x 50mil (1270±25µm x 1270±25µm)
芯片厚度	6.0mil (150 ± 15µm)
焊盘尺寸	4.0mil (100 ± 10µm in diameter)



单位: mil

◆ 光电参数: ($T_C=22^\circ\text{C}$, $I_F=350\text{mA}$)

产品型号	波长范围 (λ_D , nm)		工作电压 (V_F , V)	反向漏电流 (I_R , μA) @ $V_R=5\text{V}$	半波宽度 ($\Delta\lambda$, nm)	最大电流 (I_F , mA) DC
	Min	Max				
S-50ABMUP*-450E**	450	455	≤ 3.6	≤ 2	≤ 35	700
S-50ABMUP*-455E**	455	460				
S-50ABMUP*-460E**	460	465				
S-50ABMUP*-465E**	465	470				
S-50ABMUP*-470E**	470	475				

◆ 光强等级: ($T_C=22^\circ\text{C}$, $I_F=350\text{mA}$)

等级	W01	W02	W03	W04	W05	W06	...
Po范围(mw)	180-220	220-260	260-290	290-320	320-350	350-380	...

◆ 其它说明

- 光电参数均系三安光电测试仪器在晶圆条件下测试, 98%符合标称值范围
- 芯片封装工艺最高温度低于 280°C , 持续时间小于10秒
- GaN LED 芯片为静电敏感产品, 使用、运输时注意静电防护
- 主波长测量误差 $\pm 1.0\text{nm}$
- 可根据客户要求订做特殊规格的芯片